

## 開示の要約 (ABSTRACT OF THE DISCLOSURE)

被パターンニング薄膜の表面に、少なくとも絶縁性有機膜及び導電性膜を成膜し、成膜した導電性膜上にレジスト膜を形成した後、EB描画法によりレジスト膜をパターンニングし、パターンニングしたレジスト膜をマスクとして被パターンニング薄膜をドライエッチングによりパターンニングした後、上述の少なくとも1つの剥離可能な膜を除去する。

2024-03-04 10:00:00